

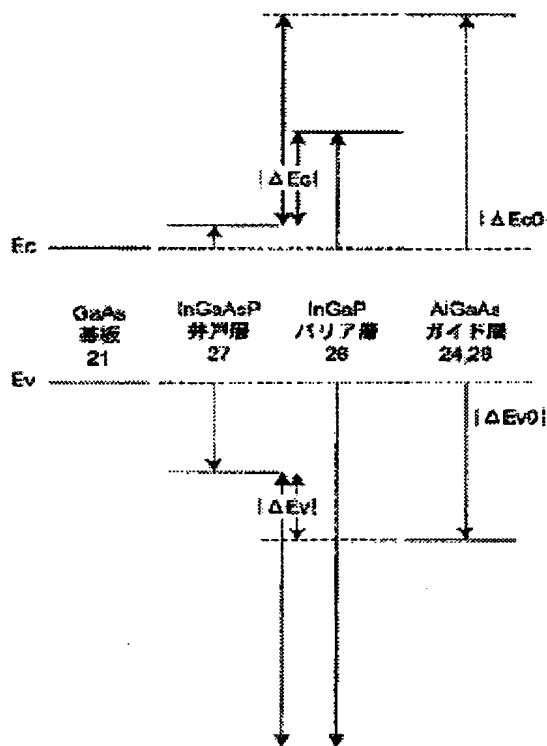
SEMICONDUCTOR LASER AND OPTICAL DISK EQUIPMENT USING THE SAME

Patent number: JP2004055747
Publication date: 2004-02-19
Inventor: YAMAMOTO KEI; OBAYASHI TAKESHI
Applicant: SHARP CORP
Classification:
- international: H01S5/343; G11B7/125
- european:
Application number: JP20020209795 20020718
Priority number(s):

Abstract of JP2004055747

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a characteristic which is aluminum free and does not depend on the size of ΔE_g .

SOLUTION: An active region is constituted of a DQW structure of an InGaP barrier layer 26 and an InGaAsP well layer 27 constituted by lattice matching with a GaAs substrate while guide layers 24, 28 are constituted of AlGaAs having an Al composition larger than 0.20. As a result, a difference in E_{cs} between guide layers 24, 28 and a well layer 27 can be set not less than 0.12eV, and the overflow of electron from the well layer 27 can be suppressed. Further, depending on the combination of InGaAsP well layer 27, a difference in E_{cs} can be increased while keeping a difference in E_{vs} between the well layer 27 and the guide layers 24, 28 small as it is. Accordingly, the overflow of an electron from the well layer 27 can be suppressed while avoiding becoming a barrier for pouring holes into the well layer 27.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-55747

(P2004-55747A)

(43) 公開日 平成16年2月19日(2004.2.19)

(51) Int. Cl.⁷

H01S 5/343

G11B 7/125

F1

H01S 5/343

G11B 7/125

A

テーマコード(参考)

5D119

5D789

5F073

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号 特願2002-209795 (P2002-209795)

(22) 出願日 平成14年7月18日(2002.7.18)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(74) 代理人 100062144

弁理士 青山 保

(74) 代理人 100086405

弁理士 河宮 治

(74) 代理人 100084146

弁理士 山崎 宏

(72) 発明者 山本 圭

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

(72) 発明者 大林 健

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シャープ株式会社内

最終頁に続く

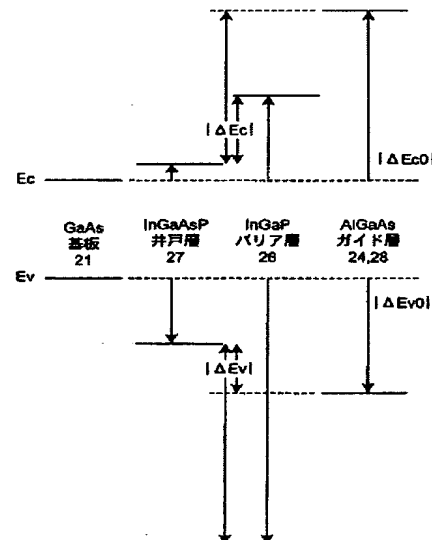
(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置およびそれを用いた光ディスク装置

(57) 【要約】

【課題】 A1フリーで且つ ΔE_g の大きさに因らずに特性を向上させる。

【解決手段】 活性領域をInGaPバリア層26とGaAs基板と格子整合したInGaAsP井戸層27とのDQW構造とし、A1組成が0.20よりも大きいAlGaAsでガイド層24、28を構成する。その結果、ガイド層24、28と井戸層27との $|\Delta E_c|$ を0.12eV以上にでき、井戸層27からの電子のオーバーフローを抑制することができる。更に、InGaAsP井戸層27と組み合わせることによって、小さな E_g のガイド層24、28で、井戸層27とガイド層24、28との $|\Delta E_v|$ を小さいままに $|\Delta E_c|$ を大きくすることが可能になる。すなわち、井戸層27へのホール注入のバリアにはならないようにし、且つ、井戸層27からの電子のオーバーフローを抑制することができる。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

GaAs 基板上に、少なくとも、下部クラッド層と、下部ガイド層と、1つまたは複数の井戸層とバリア層とが積層されて成る量子井戸を含む活性領域と、上部ガイド層と、上部クラッド層が形成された発振波長が760nmより大きく且つ800nmより小さい半導体レーザ装置において、

上記井戸層およびバリア層は、InGaP、InGaAsPあるいはGaAsPの何れかで構成され、

上記ガイド層は、 $Al_xGa_{1-x}As$ ($0.20 < x \leq 1$) で構成されていることを特徴とする半導体レーザ装置。

10

【請求項 2】

請求項 1 に記載の半導体レーザ装置において、

上記ガイド層の III 族元素中における Al の組成比を表わす上記 x の値は 0.25 よりも大きいことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 3】

請求項 1 あるいは請求項 2 に記載の半導体レーザ装置において、

上記下部クラッド層および上部クラッド層は、Al を含んで構成されており、上記 x の値は、上記下部クラッド層および上部クラッド層の Al の組成比の値よりも小さいことを特徴とする半導体レーザ装置。

20

【請求項 4】

請求項 3 に記載の半導体レーザ装置において、

上記 x の値は、段階的にあるいは連続的に、且つ、上記下部クラッド層および上部クラッド層に近づく程大きくなるように、変化していることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至請求項 4 の何れか一つに記載の半導体レーザ装置において、

上記ガイド層における少なくともバリア層に接している部分の上記 x の値は、0.4 よりも小さいことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 の何れか一つに記載の半導体レーザ装置において、

上記井戸層は、圧縮歪を有することを特徴とする半導体レーザ装置。

30

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 の何れか一つに記載の半導体レーザ装置において、

上記バリア層は、引張歪を有することを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 7 の何れか一つに記載の半導体レーザ装置を、発光装置として用いたことを特徴とする光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、活性領域に Al を含まない発振波長 780nm 帯 (760nm より大きく 800nm より小さい) の半導体レーザ装置、および、その半導体レーザ装置を用いた光ディスク装置に関する。

40

【0002】

【従来の技術】

CD (コンパクトディスク) や MD (ミニディスク) 等のディスクを再生するための半導体レーザ装置として、780nm 帯の半導体レーザ装置が広く使用されている。その中でも、高速書き込み可能な CD-R (CD recordable) 用の半導体レーザ装置として、120mW 以上の高出力でも信頼性の高い半導体レーザ装置が強く望まれている。

【0003】

ところで、井戸層/バリア層に Al が入っている従来の AlGaAs 量子井戸構造の場合

50

には、特に高温、高出力時における信頼性が低下するという問題がある。これは、Alが活性な物質であるために酸素等の微量の不純物とも反応してしまい、材料の劣化を増幅してしまう為と考えられている。それに対抗する1つの方法として、上記井戸層／バリア層にAlが入っていない構造にすることによって、高出力、高信頼性を実現することが考えられる。しかしながら、実際には、780nm帯において、120mW以上の高出力で十分な信頼性を有する半導体レーザ装置は未だ出現していない。

【0004】

上記井戸層／バリア層にAlが入っていない構造の発振波長810nmの半導体レーザ装置として、特開平11-220244号公報、および、Japanese Journal of Applied Physics Vol. 38 (1999) pp. L387-L389に開示されているようなものが提案されている。そこで、この従来の技術に基づいて、780nmで発振する半導体レーザ装置を作成してみた。

【0005】

図12は、上記井戸層／バリア層にAlが入っていないInGaAsP系量子井戸構造の半導体レーザ装置を示す構造図である。また、図13は、図12に示す半導体レーザ装置における活性領域近傍のエネルギーバンドギャップ(Eg)のダイアグラムを示す。

【0006】

図12において、1はn型GaAs基板、2はn型Al_{0.63}Ga_{0.37}As下部クラッド層、3はIn_{0.484}Ga_{0.516}P下部ガイド層、4は活性領域である。ここで、活性領域4は、バリア層5と井戸層6とから成る二重量子井戸(DQW)構造を有している。また、7はIn_{0.484}Ga_{0.516}P上部ガイド層、8はp型のAl_{0.63}Ga_{0.37}As上部クラッド層、9はp型のGaAs保護層、10はSiO₂電流ブロック層、11はn側電極、12はp側電極である。バリア層5は、In_{0.4}Ga_{0.6}Pで構成され、歪は引張歪-0.62%で、層厚は5a, 5cが8nmであり5bが7nmである。尚、In_{0.4}Ga_{0.6}PのEgは、歪を考慮しない場合は2.02eV程度と算出されるが、引張歪による影響によって1.93eV~1.96eV程度になると考えられる。井戸層6は、In_{0.162}Ga_{0.838}As_{0.671}P_{0.329}で構成されており、Egは1.57eVで、基板と格子整合しており、層厚は6a, 6b共に5nmである。また、AlGaAs上部クラッド層8は、リッジストライプ構造を有し、ストライプ幅は2.5μmである。

【0007】

従来の井戸層／バリア層にAlが入っていない半導体レーザ装置では、In_{0.484}Ga_{0.516}Pガイド層(Eg=1.89eV)とInGaAsP井戸層の間にIn_{0.4}Ga_{0.6}Pバリア層を挿入して、井戸層に隣接する層(つまり、バリア層5)とのEgの差「ΔEg」を0.36eV~0.39eVと、井戸層／バリア層にAlが入っている半導体レーザ装置よりも大きくしている。例えば、AlGaAs系の半導体レーザの量子井戸構造では、通常ΔEg=0.25eV程度である。このように、上記従来の井戸層／バリア層にAlが入っていない半導体レーザ装置では、バリア層5に用いるAlフリーの材料としてΔEgをできるだけ大きくとれる材料を選び、確実なキャリアの閉じ込めを図っているのである。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来の井戸層／バリア層にAlが入っていないInGaAsP系量子井戸構造の半導体レーザ装置においては、以下のような問題がある。すなわち、上記半導体レーザ装置の特性を測定したところ、閾値電流は100mAと高く、良好な特性が得られない。また、温度特性も非常に悪く、80℃以上では発振しないのである。尚、上記井戸層／バリア層にAlが入っているAlGaAs系の780nm帯の半導体レーザ装置の場合は、閾値電流が35mA、温度特性が110K程度である。したがって、上記AlGaAs系の半導体レーザ装置と比較した場合には、逆に特性が悪化しているのである。

【0009】

そこで、この発明の目的は、 ΔE_g の大きさに拘らず特性を著しく向上させることができるAlフリーの半導体レーザ装置、および、その半導体レーザ装置を用いた光ディスク装置を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、第1の発明は、GaAs基板上に、少なくとも、下部クラッド層と、下部ガイド層と、1つあるいは複数の井戸層とバリア層とが積層されて成る量子井戸を含む活性領域と、上部ガイド層と、上部クラッド層が形成された発振波長が760nmより大きく且つ800nmより小さい半導体レーザ装置において、上記井戸層およびバリア層はInGaP、InGaAsPあるいはGaAsPの何れかで構成され、上記ガイド層は $Al_xGa_{1-x}As$ ($0.20 < x \leq 1$) で構成されていることを特徴としている。

10

【0011】

後に詳述するように、InGaAsPは、組成を変えると、同じ E_g であってもコンダクションバンドのエネルギー (E_c) とバレンスバンドのエネルギー (E_v) との値は変わってくる。特に、格子定数がGaAs基板に近い組成であるInGaAsPの E_g は、バレンスバンド側に広がってくる。そのために、井戸層およびバリア層にInGaAsP系材料を用いた場合には、両層の間の ΔE_g を大きな値に設定しても、 E_v の差 ($|\Delta E_v|$) ばかりが大きくなって、 E_c の差 ($|\Delta E_c|$) はAlGaAs系の半導体レーザ装置程度の大きさを確保することができない。

20

【0012】

したがって、上記バリア層およびガイド層としてInGaPを用いた従来の780nm帯半導体レーザ装置の場合には、 $|\Delta E_c|$ 小による電子のオーバーフローが生じて、閾値電流の上昇や温度特性の悪化等の特性不良の原因となっている。

【0013】

上記構成によれば、InGaP、InGaAsPあるいはGaAsPの何れかで構成されるAlを含まないバリア層の外側に、III族中のAl組成比が0.20より大きいAlGaAsガイド層が設けられている。したがって、上記InGaP、InGaAsPあるいはGaAsPの何れかで構成されるAlを含まない井戸層と上記ガイド層との $|\Delta E_c|$ が、0.12eV程度以上に設定される。この0.12eV程度とは、AlGaAs系半導体レーザの量子井戸構造において、バリア層としてIII族のAl組成が0.27程度のAlGaAsを用いた場合の、バリア層と井戸層との ΔE_c に相当する。したがって、AlGaAs系の半導体レーザと同等以上に電子のオーバーフローが抑制される。

30

【0014】

その結果、上記InGaPガイド層を用いた半導体レーザ装置における特性不良の原因であった井戸層からの電子のオーバーフローを解消することができ、活性領域にAlを含まない780nm帯の半導体レーザ装置の特性が、著しく向上されるのである。さらに、上記Alを含まないバリア層の存在によって、上記井戸層には、Alを含む上記AlGaAsガイド層が隣接されることはない。したがって、高い信頼性が確保される。

【0015】

また、1実施例では、上記第1の発明の半導体レーザ装置において、上記ガイド層のIII族元素中におけるAlの組成比を表わす上記xの値は0.25よりも大きくなっている。

40

【0016】

この実施例によれば、上記AlGaAsガイド層と井戸層との $|\Delta E_c|$ を0.12eVよりも確実に大きくして、上記井戸層からの電子のオーバーフローがより確実に抑制される。

【0017】

また、1実施例では、上記第1の発明の半導体レーザ装置において、上記下部クラッド層および上部クラッド層はAlを含んで構成されており、上記xの値は上記下部クラッド層

50

および上部クラッド層のA1の組成比の値よりも小さくなっている。

【0018】

この実施例によれば、上記AlGaAsガイド層の $|\Delta E_c 0|$ およびGaAs基板に対するEvの差である $|\Delta E_v 0|$ が、上記下部クラッド層および上部クラッド層よりも小さくなる。したがって、上記ガイド層中で電子のオーバーフローが抑え込まれて、温度特性の向上が図られる。

【0019】

また、1実施例では、上記第1の発明の半導体レーザ装置において、上記xの値は、段階的にあるいは連続的に、且つ、上記下部クラッド層および上部クラッド層に近づく程大きくなるように、変化している。

10

【0020】

この実施例によれば、上記AlGaAsガイド層の $|\Delta E_c 0|$ および $|\Delta E_v 0|$ が、上記井戸層側から下部クラッド層および上部クラッド層側に向かって順次大きくなっている。したがって、より確実に上記ガイド層中で電子のオーバーフローが抑え込まれる。

【0021】

また、1実施例では、上記第1の発明の半導体レーザ装置において、上記ガイド層における少なくともバリア層に接している部分の上記xの値は、0.4よりも小さくなっている。

【0022】

この実施例によれば、上記ガイド層における井戸層に近い領域におけるA1組成が低くなっている。したがって、信頼性に悪影響を及ぼすことが防止される。

20

【0023】

また、1実施例では、上記第1の発明の半導体レーザ装置において、上記井戸層は圧縮歪を有している。

【0024】

この実施例によれば、上記井戸層には圧縮歪が導入されている。したがって、低閾値電流化が図られる。

【0025】

また、1実施例では、上記第1の発明の半導体レーザ装置において、上記バリア層は引張歪を有している。

30

【0026】

この実施例によれば、低閾値電流化を図るために上記井戸層に圧縮歪が導入された場合に、引張歪が導入された上記バリア層は歪補償機能を呈する。したがって、結晶内の欠陥が減少して、より高い信頼性が得られるのである。

【0027】

また、第2の発明の光ディスク装置は、上記第1の発明の半導体レーザ装置を発光装置として用いたことを特徴としている。

【0028】

上記構成によれば、CD/MD用の光ディスク装置の発光装置として、従来よりも高い光出力で安定に動作する半導体レーザ装置が用いられている。したがって、光ディスクの回転数を従来よりも高速にしてもデータの読み書きが可能となり、特にCD-R、CD-RW (CDrewritable) 等への書き込み時に問題となっていた光ディスクへのアクセス時間が格段に短くなる。

40

【0029】

【発明の実施の形態】

以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。

【0030】

<第1実施の形態>

図1は、本実施の形態の半導体レーザ装置における構成を示す図である。本実施の形態は、InGaAsP井戸層/InGaPバリア層の量子井戸活性領域とAlGaAsガイド

50

層とを有する発振波長が780 nmの半導体レーザ装置に関する。

【0031】

図1において、21はn型GaAs基板、22はn型GaAsバッファ層（層厚0.5 μ m）、23はn型Al_{0.35}Ga_{0.65}As下部クラッド層（層厚1.7 μ m）、24はAl_{0.35}Ga_{0.65}As下部ガイド層（層厚45 nm）、25は活性領域である。ここで、活性領域25は、バリア層26と井戸層27とから成る二重量子井戸（DQW）構造を有している。また、28はAl_{0.35}Ga_{0.65}As上部ガイド層（層厚45 nm）、29aはp型Al_{0.35}Ga_{0.65}As上部第1クラッド層（層厚0.2 μ m）、30はp型GaAsエッチングストップ層（層厚3 nm）、29bはリッジストライプ形状のp型Al_{0.35}Ga_{0.65}As上部第2クラッド層（層厚1.28 μ m）、31はp型GaAs保護層（層厚0.7 μ m）、32はn型Al_{0.7}Ga_{0.3}As第1電流ブロック層（層厚0.6 μ m）、33はn型GaAs第2電流ブロック層（層厚0.7 μ m）、34はp型GaAs埋込み保護層（層厚0.6 μ m）、35はp型GaAsキャップ層（層厚2 μ m）、36はn側電極、37はp側電極である。

【0032】

尚、上記バリア層26はIn_{0.4}Ga_{0.6}Pで構成され、歪は引張歪-0.62%で、層厚は26a、26cが8 nmであり、26bが7 nmである。尚、In_{0.4}Ga_{0.6}PのE_gは、歪を考慮しない場合は2.02 eV程度と算出される。しかしながら、引張歪による影響によって、1.93 eV~1.96 eV程度になると考えられる。井戸層27は、In_{0.162}Ga_{0.838}As_{0.671}P_{0.329}で構成され、E_gは1.57 eVで、基板と格子整合しており、層厚は27a、27b共に5 nmである。尚、井戸層27とバリア層26との| ΔE_g |は0.36 eV~0.39 eVである。また、AlGaAsガイド層24、28のE_gは1.86 eVである。

【0033】

ところで、上記AlGaAs系の半導体レーザ装置では、通常井戸層とバリア層との| ΔE_g |は0.25 eV程度であり、この ΔE_g が0.20 eV程度になるとキャリアがオーバーフローして特性の劣化が見られるようになる。

【0034】

上記構成のInGaAsP井戸層/InGaPバリア層/AlGaAsガイド層半導体レーザ装置は、以下のようにして作成することができる。すなわち、まず、(100)面を有するGaAs基板21上に、GaAsバッファ層22、AlGaAs下部クラッド層23、AlGaAs下部ガイド層24、3層のバリア層26と2層の井戸層27を交互に配置して成るDQW構造の活性領域25、AlGaAs上部ガイド層28、AlGaAs上部第1クラッド層29a、GaAsエッチングストップ層30、AlGaAs上部第2クラッド層29b、GaAs保護層31を、有機金属気相成長法によって順次結晶成長させる。さらに、GaAs保護層31上におけるリッジストライプ部を形成する部分に、ストライプ方向が(011)方向であるようなレジストマスクを写真工程によって形成する。

【0035】

次に、上記レジストマスク以外の部分におけるGaAs保護層31およびAlGaAs上部第2クラッド層29bのみをエッチング除去して、リッジストライプ部を形成する。そして、このリッジストライプ部の上側及び両側を含む全体に、AlGaAs第1電流ブロック層32、GaAs第2電流ブロック層33、GaAs埋込み保護層34を、有機金属気相成長法によって順次結晶成長させる。その際に、上記リッジストライプ部上には、リッジストライプ部の形状を反映して電流ブロック層32、33および埋込み保護層34が凸状に形成される。

【0036】

次に、上記GaAs埋込み保護層34上における上記凸状部を除く領域にレジストマスクを形成する。そして、上記凸状部の埋込み保護層34、第2電流ブロック層33および第1電流ブロック層32をエッチングにより順次除去して、リッジストライプ部の頂部を露出させる。その後、全面に、GaAsキャップ層35を有機金属気相成長法によって結晶

成長させる。そして最後に、基板21の表面にn側電極36を形成し、キャップ層35の表面にp側電極37を形成する。以上のようにして、ストライプ幅2.5 μ mの埋込リッジ構造を有するInGaAsP井戸層/InGaPバリア層/AlGaAsガイド層の半導体レーザ装置が形成される。

【0037】

上述のようにして形成された半導体レーザ装置を、共振器長800 μ mで壁開し、端面反射コーティングを施し、ステムにマウントした後、素子特性の測定を行った。その結果、閾値電流 $I_{th}=38$ mA、温度特性 $T_0=108$ Kを呈した。すなわち、本実施の形態における半導体レーザ装置では、従来の井戸層/バリア層にAlが入っていないInGaAsP系量子井戸構造の半導体レーザ装置に比べ、井戸層27およびバリア層26の構成は同様であるにも拘らず、閾値電流 I_{th} 、温度特性 T_0 共に向上させることができる。以下、その理由に付いて検証してみる。

10

【0038】

(E_c , E_v の机上検討)

半導体の E_g は、コンダクションバンドのエネルギー(E_c)およびバレンスバンドのエネルギー(E_v)の差である。しかしながら、例えば同じ E_g であっても、 E_c および E_v は材料系や組成等によって相違する。一般に、AlGaAs系は E_c , E_v が高いのに対して、InGaAsP系では E_c , E_v が低いと言われている。異なる半導体層間のヘテロ界面においては、両層間の E_c 同士の差及び E_v 同士の差(ΔE_c , ΔE_v)が電子やキャリアの振る舞いに影響を与える。そこで、本実施の形態の半導体レーザ装置において井戸層27に用いているInGaAsPおよびガイド層24に用いているAlGaAsの組成に対する E_c , E_v について着目し、その関係について検討を行ってみる。

20

【0039】

以下においては、半導体の E_g , E_c , E_v の大小を、両半導体レーザ装置において基板に用いているGaAsの E_g , E_c , E_v を基準にしてその基準に対する差の値 $|\Delta E_g|$, $|\Delta E_c|$, $|\Delta E_v|$ で表現することにする。また、 $|\Delta E_g|$ は $|\Delta E_c| + |\Delta E_v|$ である。ここで、 $|\Delta E_g|$ のうち $|\Delta E_c|$ が占める割合を、 $|\Delta E_c| / |\Delta E_g|$ と表現する。

【0040】

そうすると、InGaPの $|\Delta E_c| / |\Delta E_g|$ については

30

$$|\Delta E_c| / |\Delta E_g| = 0.18$$

という数値がAppl. Phys. Lett. 66, p1785 (1995)に開示されており、これを検討に使用する。一方、GaAsPの $|\Delta E_c| / |\Delta E_g|$ については、上記InGaPより大であることは一般に知られてはいるが、具体的な数値は不明である。そこで、GaAsPの $|\Delta E_c| / |\Delta E_g|$ として幾つかの値を設定し、更にInGaPとGaAsPとの間の組成であるInGaAsPについては、組成に応じてInGaPの値とGaAsPの値との間で変化すると仮定し、各組成におけるInGaAsPの $|\Delta E_g|$, $|\Delta E_c|$ 及び $|\Delta E_v|$ がどのようになるかを検討してみる。ここでは、実際のGaAsP特性に最も合った例として、GaAsPの $|\Delta E_c| / |\Delta E_g|$ を0.60とした場合を示す。尚、InGaAsP系の E_g 自体についても、実験結果に基づいて組成との関係を推定した。これは、InGaAsP系の E_g について、組成との関係式が幾つか提示されてはいるが、互いに相違しており明確になっていないためである。尚、AlGaAsの $|\Delta E_c| / |\Delta E_g|$ については、一般に0.6~0.65と言われており、0.6として検討を行った。

40

【0041】

図4は、InGaAsPについて、横軸xをIII族のGa組成とする一方、縦軸yをV族のP組成とした平面上に、同じ E_g となる(x, y)を結んで等 E_g 曲線を描いた図である。図5は、横軸xをIII族のGa組成とする一方、縦軸yをV族のP組成とした平面上に、同じ E_c となる(x, y)を結んで等 E_c 曲線を描いた図である。尚、 $|\Delta E_c|$ を50meV毎の等間隔で描いている。また、図6は、横軸xをIII族のGa組成

50

とする一方、縦軸 y を V 族の P 組成とした平面上に、同じ E_v となる (x, y) を結んで等 E_v 曲線を描いた図である。尚、 $|\Delta E_v 0|$ を 50 meV 毎の等間隔で描いている。図 7 は、横軸 x を III 族の Ga 組成とする一方、縦軸 y を V 族の P 組成とした平面上に、GaAs に対する歪量が同じになる (x, y) を結んで等歪曲線（等格子定数曲線）を描いた図である。ところで、歪による E_g , E_c , E_v の変化については、InGaP の圧縮歪の場合に関して評価した例が「J. Appl. Phys., 54, 4, pp. 2052~2056 (1983)」に開示されている。しかしながら、その他の InGaAsP や GaAsP の種々の組成によってどのように変化するかが不明であるため、図 4~図 6 においては歪の影響は考慮してはいない。

【0042】

上記等 E_g 線と等 E_c 線と等 E_v 線とを比較すると、上記等 E_g 線上に沿って組成を InGaP に近づけると、 $|\Delta E_v 0|$ は大きくなるが $|\Delta E_c 0|$ は若干小さくなり、 E_g はバレンスバンド側に広がることが判る。逆に、組成を GaAsP に近づけると、 $|\Delta E_v 0|$ は小さくなるが $|\Delta E_c 0|$ が大きくなり、 E_g はコンダクションバンド側に広がることを判る。

【0043】

図 8 に、GaAs 基板上に格子整合する InGaAsP および AlGaAs の E_c , E_v の関係を示している。InGaAsP 系材料は、AlGaAs 系材料よりも $|\Delta E_v 0|$ が大きくなり $|\Delta E_c 0|$ が小さくなることを判る。また、図 8 には、本実施の形態におけるバリア層 26 に相当する $In_{0.4}Ga_{0.6}P$ についても比較のために示している。尚、この $In_{0.4}Ga_{0.6}P$ の組成においては -0.64% の引張歪を有しており、図 8 においては、歪の影響を考慮した $|\Delta E_c 0|$ の推定値を記載している。この推定値は、圧縮歪 InGaP での E_g の変化の報告例を参考にしたものであって、飽くまで目安でしかない。

【0044】

（机上検討図と本実施の形態の比較、図 4~図 7 から判る効果）

図 4~図 7 に、本実施の形態半導体レーザ装置における InGaAsP 井戸層 27 および InGaP バリア層 26 の各組成 (x, y) 点を、夫々○, ●で示している。但し、InGaP バリア層 26 は引張歪であるため、 E_g , $|\Delta E_c 0|$, $|\Delta E_v 0|$ 共に、実際にはより小さい値になると考えられる。図 5 より $|\Delta E_c 0|$ を読み取り、図 6 より $|\Delta E_v 0|$ を読み取ることができる。また、図 8 に、井戸層 27, ガイド層 24, 28 およびバリア層 26 に該当する組成を、夫々▲1▼, ▲2▼, ▲3▼で示している。それに基づいて、GaAs 基板 21, InGaAsP 井戸層 27, InGaP バリア層 26 および AlGaAs ガイド層 24, 28 のエネルギーバンドの関係を描くと図 3 に示すようになる。さらに、本実施の形態における素子構造の活性領域近傍のエネルギーバンドを描くと図 2 (a) に示すようになる。尚、図 2 (b) に、InGaP ガイド層を用いた上記従来の半導体レーザ装置のエネルギーバンドを示している。但し、クラッド層の組成は、本実施の形態に合わせて $Al_{0.5}Ga_{0.5}As$ としている。

【0045】

図 2 (a) 及び図 2 (b) において、本実施の形態の半導体レーザ装置と従来の半導体レーザ装置とを比較すると、先ず第 1 に明確に判ることは、ガイド層同士の比較において、本実施の形態の半導体レーザ装置においては、従来の半導体レーザ装置の場合よりも、ガイド層の E_g は小さいが、井戸層とガイド層との $|\Delta E_c|$ は逆に大きくなっていることが判る。これによって、InGaP バリア層 26 からの電子のオーバーフローが AlGaAs ガイド層 24, 28 によって抑制されるために、従来の InGaP ガイド層半導体レーザ装置に対して、閾値電流の低減および温度特性の向上に繋がったと推定される。

【0046】

（AlGaAs ガイド層組成の有効な範囲の決定）

図 5 および図 6 は、上述したように GaAsP の $|\Delta E_c 0|/|\Delta E_g 0|$ を 0.60 と仮定した場合のものであり、真の曲線は不明である。しかしながら、本実施の形態の半

10

20

30

40

50

導体レーザ装置と上記従来の半導体レーザ装置とから得られた素子特性が、上述したように、図5および図6による推定に対して大きな齟齬がないために、図4～図7に示す曲線が有する傾向は、大まかには実態を表わしていると判断される。

【0047】

以下、この判断に基づいて、AlGaAs組成がガイド層として有効に機能する $|\Delta E_c|$ の範囲について述べる。

【0048】

上記井戸層からのキャリアのオーバーフローについては電子が支配的と考え、 $|\Delta E_c|$ を不必要に小さくしないように設定することにする。尚、発振波長が780nmの半導体レーザ装置におけるInGaAsP井戸層では、 $|\Delta E_c| = \text{約} 0.03 \text{ eV}$ であり、 $|\Delta E_v| = \text{約} 0.12 \text{ eV}$ であると推定される。但し、この値は、井戸層の歪量等によって変動するので厳密ではない。

10

【0049】

先ず、 $|\Delta E_c|$ の最小値については、井戸層からの電子のオーバーフローを防ぐために、ガイド層と井戸層の ΔE_c が0.12eV程度以上になるように設定する必要がある。この0.12eVは、AlGaAs井戸層を有する780nm帯半導体レーザ装置において、III族のAl組成が0.27程度であるAlGaAsをガイド層として用いた場合に相当する。本実施の形態の半導体レーザ装置の場合は、井戸層27が $|\Delta E_c| = \text{約} 0.03 \text{ eV}$ であるInGaAsPであることから、ガイド層24, 28の $|\Delta E_c| > \text{約} 0.15 \text{ eV}$ ($= \text{約} 0.03 \text{ eV} + 0.12 \text{ eV}$) が条件となる。そして、この $|\Delta E_c|$ に相当するAlGaAsは、Al組成が0.20よりも大きいAlGaAsとなる。但し、これは最低限の ΔE_c を確保するための値であり、より確実にキャリアのオーバーフローを防ぐために、はAl組成が0.25より大きいAlGaAsをガイド層24, 28として用いることが望ましい。

20

【0050】

次に、 $|\Delta E_c|$ の最大値については、電子の注入は相当大的なバリアでなければあまり影響はないと考え、特に考慮しないものとする。本実施の形態の半導体レーザ装置の場合には、ガイド層24, 28のAl組成は0.35であるので十分な ΔE_c が得られている。

【0051】

(Alフリーによる高信頼性)

30

本実施の形態においては、井戸層27および井戸層27に接するバリア層26にAlを含んでいないために、高温、高出力時においても、高い信頼性を得ることが可能である。仮に、ガイド層24, 28に接するバリア層26を無くして、AlGaAsガイド層24, 28とInGaAsP井戸層27とを隣接させても、井戸層27からのキャリアのオーバーフローを抑制できる可能性はある。しかしながら、不純物をより多く含むAlを含むガイド層24, 28は、発光層あるいはそれに隣接する層として用いると非発光再結合が発生して活性領域での結晶の劣化を促進させるので、望ましくはない。

【0052】

また、本実施の形態においては、上記量子井戸活性領域における最外のバリア層26a, 26cの外側がAlGaAsのガイド層24, 28となっている。しかしながら、InGaPバリア層26の層厚を4nm以下にすると、高温、高出力時での信頼性が低下する。これは、ガイド層24, 28のAlの影響と考えられる。したがって、InGaPバリア層26の層厚を4nmより大きくすることによって、ガイド層24, 28のAlの影響を大幅に抑制することができ、高温、高出力時においても高い信頼性を得ることができるのである。

40

【0053】

(InGaAsP井戸層による E_c , E_v に関する利点)

図3から判るように、上記InGaAsP井戸層27は、GaAs基板21に比較して、 E_g はバレンスバンド側に広がって $|\Delta E_c| < |\Delta E_v|$ となる。これとは逆に、

50

AlGaAsのガイド層24, 28は、Egはコンダクションバンド側に広がって $|\Delta Ec| > |\Delta Ev|$ となる。したがって、InGaAsP井戸層27とAlGaAsのガイド層24, 28との組み合わせは、例えばAlGaAsを井戸層とした場合に比較して、井戸層27とガイド層24, 28との ΔEc および ΔEv を考えると、 $|\Delta Ec|$ をより大きくでき、 $|\Delta Ev|$ をより小さくできる。すなわち、本実施の形態によれば、小さなEgのガイド層で $|\Delta Ev|$ を小さいままに $|\Delta Ec|$ を大きくすることが可能になるのである。したがって、ガイド層24, 28のAl組成は、少なくとも0.20より大きく設定すれば本実施の形態における効果が現れるのである。尚、その場合におけるAl組成は、AlGaAs井戸層を有する780nm帯半導体レーザ装置におけるガイド層のAl組成よりも0.05以上少ない。

10

【0054】

本実施の形態の半導体レーザ装置においては、AlGaAsのガイド層24, 28のAl組成を0.35としているが、0.20より大きければよく、Al組成を0.35より下げても差し支えない。その場合には、キャリアのオーバーフローの効果は少し低下する代わりに、Alによる信頼性の低下をさらに抑制することが可能になる。

【0055】

以上のごとく、本実施の形態においては、半導体レーザ装置における活性領域25を、バリア層26と井戸層27とから成るDQW構造とし、バリア層26をInGaPで構成する一方、井戸層27をGaAs基板21と格子整合した $In_{0.162}Ga_{0.838}As_{0.671}P_{0.329}$ で構成している。更に、ガイド層24, 28を $Al_{0.35}Ga_{0.65}As$ で構成している。このように、ガイド層24, 28をAlGaAsで構成することによって、ガイド層として従来のごとくInGaPを用いた場合に比してガイド層のEgは小さくなるが、井戸層とガイド層との $|\Delta Ec|$ を大きくすることができる。したがって、InGaPバリア層26からの電子のオーバーフローをAlGaAsガイド層24, 28によって抑制することができる。その結果、従来のInGaPガイド層半導体レーザ装置よりも、閾値電流の低減および温度特性の向上を図ることができるのである。

20

【0056】

さらに、上記ガイド層24, 28を、0.20よりも大きいAl組成のAlGaAsとすることによって、ガイド層24, 28と井戸層27との ΔEc を0.12eV以上に設定することができ、井戸層27からの電子のオーバーフローを抑制することができる。さらに、InGaAsP井戸層27と組み合わせることによって、小さなEgのガイド層24, 28で、井戸層27とガイド層24, 28との $|\Delta Ev|$ を小さいままに $|\Delta Ec|$ を大きくすることが可能になる。すなわち、井戸層27へのホール注入のバリアにはならないようにし、且つ、井戸層27からの電子のオーバーフローを抑制することができるのである。

30

【0057】

したがって、上述した従来の井戸層／バリア層にAlが入っていないInGaAsP系量子井戸構造の半導体レーザ装置に比べ、井戸層27およびバリア層26の構成は同様であるにも拘らず、閾値電流 $I_{th} = 38\text{mA}$ 、温度特性 $T_0 = 108\text{K}$ と、InGaPガイド層と比べて素子特性を著しく向上させることができるのである。

40

【0058】

その際に、上記InGaPバリア層26の層厚を4nmより大きくしているので、AlGaAsガイド層24, 28のAlの影響を大幅に抑制することができ、高温、高出力時に高い信頼性を得ることができる。

【0059】

(種々の構成の自由度)

本実施の形態においては、上記InGaAsP井戸層27をGaAs基板21と同じ格子定数としたが、InGaAsP井戸層27に歪を加えてもAlGaAsのガイド層24, 28は有効であり、素子特性の向上に繋がる。また、本実施の形態における井戸数は2層

50

であるが、これに限るものではなく、任意の井戸数で同様の効果が得られる。また、本実施の形態においては埋込リッジ構造としたがこれに限定されるものではなく、リッジ構造、内部ストライプ構造、埋込ヘテロ構造等のあらゆる構造に対して同様の効果を得ることができる。

【0060】

また、本実施の形態においては、上記基板としてn型基板を用いたが、p型基板を用いると共に各層のn型とp型とを入れ換えても同様の効果を得ることができる。また、波長を780nmとしたがこれに限るものではなく、760nmよりも大きく且つ800nmよりも小さい所謂780nm帯であれば同様の効果を得ることができるのである。

【0061】

<第2実施の形態>

本実施の形態は、InGaAsP井戸層/GaAsPバリア層の量子井戸活性領域とAlGaAsガイド層とを有する発振波長が780nmである半導体レーザ装置に関する。本実施の形態の半導体レーザ装置は、上記第1実施の形態の半導体レーザ装置において、バリア層26をInGaPからGaAs_{0.72}P_{0.28}に置き換えたものであり、バリア層以外の構成および製造方法に変更はない。したがって、以下の説明には、上記第1実施の形態における図1をそのまま用いることにする。

【0062】

上記GaAs_{0.72}P_{0.28}バリア層26は、歪が引張歪-1%で、層厚は26a, 26cが8nmであり26bが7nmである。GaAs_{0.72}P_{0.28}のE_gは、歪を考慮しない場合は1.77eV程度と算出される。尚、引張歪によるE_gへの影響については本材料組成付近では明確ではないので、ここでは考慮しないものとする。井戸層27は、In_{0.162}Ga_{0.838}As_{0.671}P_{0.329}で構成され、E_gは1.57eVで、基板と格子整合しており、層厚は27a, 27b共に5nmである。井戸層27とバリア層26との|ΔE_g|は0.20eVである。また、ガイド層24, 28のE_gは1.86eVである。

【0063】

得られた半導体レーザ装置を共振器長800μmで壁開し、端面反射コーティングを施し、ステムにマウントした後に、素子特性の測定を行った。その結果、閾値電流I_{th}=25mA、温度特性T₀=140Kであった。このように、引張歪が導入されたGaAsPバリア層を用いた半導体レーザ装置では、ΔE_gが0.20eVと小さいにも拘らず、InGaPバリア層を有する上記第1実施の形態の半導体レーザ装置に比して、素子特性を著しく向上させることができる。

【0064】

(GaAsPバリア層の利点、及び、AlGaAsガイド層を併用する利点)

図2(c)に、本実施の形態の半導体レーザ装置における活性領域近傍のエネルギーバンドを示す。上記第1実施の形態におけるInGaPバリア層を有する半導体レーザ装置の場合には、図2(a)に示すエネルギーバンドからも判るように、E_v側において、ガイド層24, 28から井戸層27へ流れ込むホールに対して非常に大きなバリアができていることが判る。一方、本実施の形態におけるGaAsPバリア層の半導体レーザ装置の場合には、E_v側において、ガイド層から井戸層へ流れ込むホールに対するバリアは存在しない。図4～図7に、本実施の形態におけるバリア層のGaAsP組成を▲で示している。先に述べたように、GaAsPの|ΔE_{c0}|/|ΔE_{g0}|は0.60程度であると推定されるため、図6から判るように、InGaPと比較して|ΔE_{v0}|を大幅に小さくすることができる。したがって、バリア層としてInGaPの代わりにGaAsPを用いることによって、井戸層とバリア層とのΔE_vも小さくでき、井戸層へのホールの注入を格段に改善することができるのである。

【0065】

したがって、本実施の形態によれば、電子およびホール共に、キャリアの注入が効率よく行うことができ、閾値電流の低減に繋がったものと推定される。

10

20

30

40

50

【0066】

一方、図4および図5から判るように、上記GaAsPバリア層の $|\Delta E_c|$ については、InGaPに比べて E_g が小さくなっているにも関わらず大きくなっている。組成がGaAs_{0.72}P_{0.28}である場合の $|\Delta E_c|$ は、0.21eV程度と推定される。したがって、上述したようにInGaAsP井戸層27の $|\Delta E_c|$ は約0.03eVであるから、井戸層とバリア層との $|\Delta E_c|$ は0.18eV(=0.21eV-0.03eV)程度となる。この値は、AlGaAs井戸層を有する780nm帯半導体レーザー装置と比較しても同等レベルの大きさを有している。しかしながら、GaAsPバリア層は1%の引張歪を有するため、井戸層の両側に薄く形成することはできるのであるが、ガイド層として数10nmの厚さで形成すると欠陥が発生してしまう。そのため、ガイド層としては、GaAs基板に格子整合し、且つ、 ΔE_c を大きく設定できる材料を形成する必要がある。以上のことから、本実施の形態のごとく、ガイド層としてAlGaAsを用いるのが効果的なのである。

10

【0067】

仮に、上記ガイド層としてGaAs基板に格子整合するInGaAsPを用いた場合には、井戸層とガイド層との $|\Delta E_c|$ は、図8からも判るように小さい値になってしまう。井戸層とバリア層との $|\Delta E_c|$ は十分大きいのであるが、バリア層の厚さは薄いので電子は容易にオーバーフローしてしまい、良好な特性を得ることはできないのである。

【0068】

本実施の形態の半導体レーザー装置におけるAl_{0.35}Ga_{0.65}Asガイド層24、28は、その $|\Delta E_c|$ が0.26eV程度であり、バリア層よりもさらに高いと推定される。したがって、キャリアのオーバーフロー抑制に関して極めて高い効果を得ることができ、温度特性T₀を向上させることができるのである。

20

【0069】

比較として、AlGaAs系の半導体レーザー装置の場合には、バリア層およびガイド層にAl_{0.35}Ga_{0.65}Asを用いると、井戸層とバリア層およびガイド層との ΔE_c は0.18eV程度となると推定される。したがって、同じAl_{0.35}Ga_{0.65}Asを用いた場合でも、本実施の形態の方が井戸層とガイド層との ΔE_c を大きく取ることができるのである。これは、上記第1実施の形態の説明においても述べたように、井戸層にInGaAsPを用いたことによる効果である。

30

【0070】

(GaAsPバリア層の有効な範囲の決定)

本実施の形態においては、上記第1実施の形態に対して、上記バリア層にGaAs_{0.72}P_{0.28}を用いることで特性を改善するようにしているが、このバリア層は適切な組成範囲のGaAsP、InGaAsPを用いることで十分な効果を得ることができる。

【0071】

以下、上記InGaAsP組成がバリア層として有効に機能する $|\Delta E_c|$ および $|\Delta E_v|$ の上限と下限とについて述べる。井戸層へのキャリア注入についてはホールが支配的と考え、 $|\Delta E_v|$ を不必要に大きくしないように設定する。また、井戸層からのキャリアのオーバーフローについては電子が支配的と考え、 $|\Delta E_c|$ を不必要に小さくしないように設定することにする。尚、発振波長が780nmの半導体レーザー装置におけるInGaAsP井戸層では、 $|\Delta E_c|$ =約0.03eVであり、 $|\Delta E_v|$ =約0.12eVであると推定される。但し、この値は、井戸層の歪量等によって変動するので厳密ではない。

40

【0072】

先ず、 $|\Delta E_v|$ の最小値については、バリア層と井戸層との ΔE_v は少なくとも正の値になる必要がある。したがって、 $|\Delta E_v|$ >約0.12eVであり、図6からP組成0.15~0.30付近に $|\Delta E_v|$ の境界が存在すると言える。

【0073】

次に、 $|\Delta E_v|$ の最大値については、ガイド層からのホールの注入を疎外しない程度

50

に抑える必要がある。ガイド層やクラッド層として、 InGaP や AlGaAs 等の GaAs 基板に格子整合する種々の材料や組成が用いられるが、少なくとも最も $|\Delta E_v 0|$ の大きい InGaP が用いられた場合よりも $|\Delta E_v 0|$ を小さくする必要があり、 $|\Delta E_v 0| < \text{約} 0.38 \text{ eV}$ (図6における GaAs に対する歪量が0の破線と InGaP の線との交点での $|\Delta E_v 0|$ の値)となる。したがって、図6から、 P 組成が $0.60 \sim 0.80$ である付近に $|\Delta E_v 0|$ の境界が存在すると言える。

【0074】

また、 $|\Delta E_c 0|$ の最小値については、井戸層からの電子のオーバーフローを防ぐために、バリア層と井戸層の ΔE_c が 0.12 eV 程度以上になるように設定する必要がある。この 0.12 eV は、 AlGaAs 系の半導体レーザ装置では、バリア層に III 族の Al 組成が 0.27 程度の AlGaAs を用いた場合に相当する。したがって、バリア層の $|\Delta E_c 0|$ は、井戸層の $|\Delta E_c 0|$ が約 0.03 eV であるから、 $|\Delta E_c 0| > \text{約} 0.15 \text{ eV}$ (約 $0.03 \text{ eV} + 0.12 \text{ eV}$)となる。図5及び図7から判るように等 E_c 線が等格子定数線と平行に近いことから、 $|\Delta E_c 0|$ に関しては井戸層の GaAs に対する歪量からの歪量の差の値で境界を設定することができる。すなわち、井戸層の歪量との歪量の差が $-0.65\% \sim -0.85\%$ の付近に $|\Delta E_c 0|$ の境界が存在すると言える。

【0075】

尚、本実施の形態の半導体レーザ装置の場合には、 AlGaAs ガイド層24, 28が存在するため、ガイド層24, 28より外側へのキャリアのオーバーフローについては問題が無い構造になっている。しかしながら、バリア層26と井戸層27との ΔE_c を上述のように大きくすることによって、不必要に多くのキャリアが Al を含む層へオーバーフローしてしまうのを抑制することができ、上記第1実施の形態の場合に比べて、より高い信頼性を得ることができるのである。

【0076】

次に、 $|\Delta E_c 0|$ の最大値については、電子の注入は相当大きなバリアでなければあまり影響はないと考え、特に考慮しないものとする。

【0077】

以上、大まかに推定した P 組成及び歪量の境界に基づいて、実際に幾種類かのバリア層の半導体レーザ装置を作成して特性を測定した結果によると、 P 組成については、 0.2 よりも大きく且つ 0.75 よりも小さい範囲が有効なのである。更には、 0.25 よりも大きく且つ 0.6 よりも小さい範囲で、極めて有効な素子特性を得ることができるのである。また、井戸層の歪量との歪量の差を -0.65% 以下に設定すると、素子特性が低下する。したがって、井戸層の歪量との歪量の差については、 -0.65% よりも大きい範囲が有効なのである。

【0078】

尚、上述した $|\Delta E_g 0|$, $|\Delta E_c 0|$, $|\Delta E_v 0|$ の推定値は、歪によるバンド構造の変化については明確なデータが無いために考慮しておらず、真の値を示しているとは限らない。しかしながら、本実施の形態において得られた範囲は、飽くまでもこれらの推定を参考にして実際に半導体レーザ装置を作成し、その特性を検討した結果に基づいて得たものである。したがって、上記推定値の真偽によって、上記範囲が左右されるものではない。

【0079】

以上のごとく、本実施の形態においては、上記第1実施の形態の半導体レーザ装置におけるバリア層26を、 InGaP から歪量 -1% が導入された $\text{GaAs}_{0.72}\text{P}_{0.28}$ に置き換えて、 InGaAsP 井戸層/ GaAsP バリア層の量子井戸活性領域と AlGaAs ガイド層との半導体レーザ装置としている。このように、バリア層26を、 0.2 よりも大きく且つ 0.75 よりも小さい P 組成であって、 -0.65% よりも大きい井戸層の歪量 (=基板の歪量) との歪量の差を有する GaAsP とし、 InGaAsP 井戸層27と組み合わせることによって、バリア層26と井戸層27とガイド層24, 28の $|\Delta$

E_{v0} を、井戸層27の $|\Delta E_{v0}| < \text{バリア層26の} |\Delta E_{v0}| < \text{ガイド層24, 28の} |\Delta E_{v0}|$ の大小関係が成立するように設定することができ、ガイド層24, 28からのホールの注入を効率良く行うことができる。さらに、バリア層26と井戸層27との間の ΔE_c を0.12 eV以上に設定することができ、井戸層27からの電子のオーバーフローを抑制することができる。

【0080】

したがって、上記井戸層27とバリア層26との ΔE_g は0.20 eVと小さいにも拘わらず、閾値電流 $I_{th} = 25 \text{ mA}$ 、温度特性 $T_0 = 140 \text{ K}$ と、InGaPバリア層と比べて素子特性を著しく向上させることができるのである。

【0081】

(種々の構成の自由度)

本実施の形態においては、上記InGaAsP井戸層27をGaAs基板21と同じ格子定数としたが、InGaAsP井戸層27に歪を加えてもGaAsPバリア層26は有効であり、素子特性の向上に繋がる。また、本実施の形態における井戸数は2層であるが、これに限るものではなく、任意の井戸数で同様の効果が得られる。また、本実施の形態においては埋込リッジ構造としたがこれに限定されるものではなく、リッジ構造、内部ストライプ構造、埋込ヘテロ構造等のあらゆる構造に対して同様の効果を得ることができる。

【0082】

また、本実施の形態においては、上記基板としてn型基板を用いたが、p型基板を用いると共に各層のn型とp型とを入れ替えても同様の効果を得ることができる。また、波長を780 nmとしたがこれに限るものではなく、760 nmよりも大きく且つ800 nmよりも小さい所謂780 nm帯であれば同様の効果を得ることができるのである。

【0083】

<第3実施の形態>

図9は、本実施の形態の半導体レーザ装置における構成を示す図である。本実施の形態は、InGaAsP圧縮歪井戸層／InGaAsPバリア層の量子井戸活性領域とAlGaAsガイド層とを有する波長780 nmの半導体レーザ装置に関する。

【0084】

図9において、41はn型GaAs基板、42はn型GaAsバッファ層(層厚 $0.5 \mu\text{m}$)、43aはn型Al_{0.4}Ga_{0.6}As下部第2クラッド層(層厚 $3.0 \mu\text{m}$)、43bはn型Al_{0.5}Ga_{0.5}As下部第1クラッド層(層厚 $0.2 \mu\text{m}$)、44aはAl_{0.42}Ga_{0.58}As下部第2ガイド層(層厚70 nm)、44bはAl_{0.32}Ga_{0.68}As下部第1ガイド層(層厚10 nm)、45は活性領域である。ここで、活性領域45は、バリア層46と井戸層47とから成るDQW構造を有している。また、48aはAl_{0.32}Ga_{0.68}As上部第1ガイド層(層厚10 nm)、48bはAl_{0.42}Ga_{0.58}As上部第2ガイド層(層厚70 nm)、49aはp型Al_{0.5}Ga_{0.5}As上部第1クラッド層(層厚 $0.2 \mu\text{m}$)、50はp型GaAsエッチングストップ層(層厚3 nm)、49bはリッジストライプ形状のp型Al_{0.5}Ga_{0.5}As上部第2クラッド層(層厚 $1.28 \mu\text{m}$)、51はp型GaAs保護層(層厚 $0.7 \mu\text{m}$)、52はn型Al_{0.7}Ga_{0.3}As第1電流ブロック層(層厚 $0.6 \mu\text{m}$)、53はn型GaAs第2電流ブロック層(層厚 $0.7 \mu\text{m}$)、54はp型GaAs埋込み保護層(層厚 $0.6 \mu\text{m}$)、55はp型GaAsキャップ層(層厚 $2 \mu\text{m}$)、56はn側電極、57はp側電極である。

【0085】

尚、上記バリア層46は、In_{0.12}Ga_{0.874}As_{0.407}P_{0.593}によって構成され、 E_g は1.98 eV、歪は引張歪-1.20%で、層厚は46a, 46cが10 nmであり46bが5 nmである。また、上記井戸層47は、In_{0.27}Ga_{0.73}As_{0.55}P_{0.45}で構成され、 E_g は1.55 eV、歪は圧縮歪0.35%で、層厚は47a, 47b共に8 nmである。尚、井戸層47とバリア層46との $|\Delta E_g|$ は0.43 eVである。

10

20

30

40

50

【0086】

上記ガイド層44b, 48aの E_g は1.82eVであり、ガイド層44a, 48bの E_g は1.95eVである。尚、歪によるバリア層46および井戸層47の E_g への影響については、本材料組成付近でも明確ではないので、本実施の形態でも考慮しないものとする。

【0087】

上記構成のInGaAsP圧縮歪井戸層/InGaAsPバリア層/AlGaAsガイド層半導体レーザ装置は、上記第1実施の形態の場合と同様の成長、プロセスの手法によってストライプ幅2 μ mの埋込リッジ構造を形成することによって作成することができる。そして、得られた半導体レーザ装置を共振器長800 μ mで壁開し、端面反射コーティングを施し、ステムにマウントした後に、素子特性の測定を行った。その結果、閾値電流 I_{th} =30mA、温度特性 T_0 =153Kであった。このように、井戸層に圧縮歪を導入すると共にInGaAsPバリア層を用いた半導体レーザ装置でも、良好な素子特性を得ることができるのである。

【0088】

図10(a)に、本実施の形態の半導体レーザ装置における活性領域近傍のエネルギーバンドを示す。本半導体レーザ装置においては、AlGaAsガイド層44, 48の夫々を2層構造としている。そして、井戸層47に近いガイド層44b, 48aについては、上記第1, 第2実施の形態のガイド層24, 28に比して、Alの組成を0.32と小さくしている。このように、発光層である井戸層47に近い領域のAl組成を小さくすることによって、信頼性をより向上させる。一方、井戸層47から遠いガイド層44a, 48bは、Alの組成を上記第1, 第2実施の形態のガイド層24, 28より大きい0.42とし、井戸層47側からクラッド層43, 49側に向かって $|\Delta E_c|$, $|\Delta E_v|$ が順次大きくなるようにしている。したがって、ガイド層44, 48中でキャリアのオーバーフローを抑え込むことができ、上記第2実施の形態の半導体レーザ装置の場合と略同等の温度特性 T_0 を得ることができるのである。

【0089】

本半導体レーザ装置の場合にも、上記バリア層46をP組成が0.60よりも小さいInGaAsPで構成しているため、バリア層にInGaPを用いた上記第1実施の形態の半導体レーザ装置に比較して、井戸層47とバリア層46との間の $|\Delta E_v|$ は小さいままに $|\Delta E_c|$ を大きくすることができるのである。

【0090】

図5および図6から判るように、本半導体レーザ装置におけるバリア層46の組成付近では等 E_c 線と等 E_v 線との組成に対する変化の仕方が大きく異なっており、適切な組成を選ぶことでバリア層46の $|\Delta E_c|$ と $|\Delta E_v|$ とをある程度独立に制御することが可能である。例えば、等 E_c 線が等格子定数線に略平行なことから、バリア層46の E_c と歪量とを殆ど変えずに E_v を変化させることも可能である。本実施の形態においては、上記第2実施の形態の半導体レーザ装置に比較して井戸層47とバリア層46との $|\Delta E_v|$ が大きくなるようにIn組成およびP組成を調整している。これによって、井戸層47へのホールの閉じ込めをも向上することが可能になる。

【0091】

また、本実施の形態においては、上記井戸層47として0.35%の圧縮歪を有するInGaAsPを用いており、低閾値電流化なる歪の効果を得ることができる。その際に、量子井戸活性領域は、圧縮歪が導入された井戸層47と-1.20%の引張歪が導入されたバリア層46とによる歪補償構造を有している。したがって、活性領域全体としての平均的な歪量を抑制することができ、井戸層を基板に格子整合させる場合と比較して、結晶内の欠陥の量を減らして、更なる信頼性の向上を図ることができる。また、平均的な歪量を小さくしたことによって、量子井戸層活性領域全体としての臨界膜厚も増大し、バリア層46a, 46bの層厚を第2実施の形態の場合の8nmに比べて10nmと厚く設定することができる。また、井戸層47からAlGaAsガイド層44, 48までの距離を10

10

20

30

40

50

nmと大きくしているのもので、ガイド層44、48から活性領域へのAlの影響を更に小さくすることができ、高温、高出力時においても高い信頼性を得ることができる。また、本実施の形態においては、上記バリア層46にInを添加してInGaAsP層としているために、Inによって転位の増殖を抑えることによって、更に高い信頼性を得ることができるのである。

【0092】

尚、上記構成の半導体レーザ装置におけるガイド層44、48は2層構造になっており、Al組成を量子井戸活性領域側からクラッド層43、49側まで2段階に増加している。しかしながら、Al組成を、量子井戸活性領域側からクラッド層43、49側まで連続的に増加させるようにしても一向に構わない。その場合におけるエネルギーバンドの例を図10(b)に示す。図10(b)においては、AlGaAsガイド層44、48のAl組成を0.32からクラッド層43b、49と同じ0.5まで増加させている。この場合にも、キャリアのオーバーフローを十分に抑制することができる。

【0093】

但し、その場合における上記ガイド層44、48のAl組成は、少なくともバリア層46に接する部分については、Alの組成は0.4より小さくするのが望ましい。これは、井戸層47に近い領域におけるAl組成が高いと、信頼性に悪影響を及ぼすからである。

【0094】

尚、本実施の形態においては、上記活性領域をInGaAsP圧縮歪井戸層／InGaAsP引張歪バリア層としたが、この組み合わせに限定されるものではない。InGaAsP無歪井戸層／InGaAsP引張歪バリア層あるいはInGaAsP圧縮歪井戸層／GaAsPバリア層の組み合わせも可能である。また、本実施の形態における井戸数は2層であるが、これに限定されるものではなく、任意の井戸数で同様の効果を得ることができる。また、本実施の形態においては、埋込リッジ構造としたがこれに限定されるものではなく、リッジ構造、内部ストライプ構造、埋込ヘテロ構造等のあらゆる構造に対して同様の効果を得ることができる。

【0095】

また、本実施の形態においては、上記基板としてn型基板を用いたが、p型基板を用いると共に各層のn型とp型とを入れ替えても同様の効果を得ることができる。また、波長を780nmとしたがこれに限定されるものではなく、760nmよりも大きく且つ800nmよりも小さい所謂780nm帯であれば同様の効果を得ることができるのである。

【0096】

<第4実施の形態>

本実施の形態は、上記各実施の形態における半導体レーザ装置を用いた光ディスク装置に関する。図11は、本実施の形態における光ディスク装置の構成図である。この光ディスク装置は、光ディスク61にデータを書き込んだり、光ディスク61に書き込まれたデータを再生したりするものであり、その際に用いる発光装置として、上記各実施の形態の何れか一つにおける半導体レーザ装置62を備えている。

【0097】

以下、本光ディスク装置の構成および動作について説明する。本光ディスク装置は、書き込みの際には、半導体レーザ装置62から出射された信号光（データ信号が重畳されたレーザ光）はコリメートレンズ63を通過して平行光となり、ビームスプリッタ64を透過する。そして、 $\lambda/4$ 偏光板65によって偏光状態が調節された後に、レーザ光照射用対物レンズ66によって集光されて光ディスク61を照射する。こうして、データ信号が重畳されたレーザ光によって、光ディスク61にデータが書き込まれる。

【0098】

一方、読み出しの際には、上記半導体レーザ装置62から出射されたデータ信号が重畳されていないレーザ光が、上記書き込みの場合と同じ経路を辿って光ディスク61を照射する。そして、データが記録された光ディスク61の表面で反射されたレーザ光は、レーザ光照射用対物レンズ66および $\lambda/4$ 偏光板65を経た後、ビームスプリッタ64で反射

されて進行方向が 90° 変更される。その後、再生光用対物レンズ67によって集光され、信号検出用受光素子68に入射される。そして、こうして信号検出用受光素子68内で、入射したレーザ光の強弱に応じて光ディスク61から読み出されたデータ信号が電気信号に変換され、信号光再生回路69によって元の情報信号に再生されるのである。

【0099】

本実施の形態における光ディスク装置においては、上述したように、従来よりも高い光出力で動作する半導体レーザ装置62を用いている。そのために、光ディスク61の回転数を従来よりも高速化しても、データの読み書きを行うことが可能である。したがって、従来、特にCD-R、CD-RW等への書き込み時に問題となっていた光ディスクへのアクセス時間を格段に短くすることができ、より快適な操作を実現した光ディスク装置を提供することが可能になるのである。

【0100】

尚、本実施の形態においては、上記各実施の形態における半導体レーザ装置を記録再生型の光ディスク装置に適用した例について説明した。しかしながら、この発明はこれに限定される物ではなく、波長780nm帯の半導体レーザ装置を発光装置として用いる光ディスク記録装置や光ディスク再生装置にも適用可能であることは言うまでもない。

【0101】

【発明の効果】

以上より明らかなように、第1の発明の発振波長が780nm帯の半導体レーザ装置は、InGaP、InGaAsPあるいはGaAsPの何れか一つで井戸層およびバリア層を構成し、 $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0.20 < x \leq 1$) でガイド層を構成したので、上記井戸層とガイド層との $|\Delta E_c|$ を、上記バリア層にAlGaAsを用いた場合の0.12eV以上に設定することができる。したがって、上記井戸層から電子がオーバーフローすることを抑制できる。

【0102】

すなわち、この発明によれば、InGaPガイド層を用いた半導体レーザ装置における特性不良の原因であった井戸層からの電子のオーバーフローを解消することができ、活性領域にAlを含まない780nm帯の半導体レーザ装置について、閾値電流の低減および温度特性の向上等、著しい特性の向上を図ることができるのである。さらに、上記Alを含まないバリア層の存在によって、上記井戸層には、Alを含む上記AlGaAsガイド層が隣接されることはない。したがって、高い信頼性を確保することができる。

【0103】

また、1実施例の半導体レーザ装置は、上記xの値を0.25よりも大きくしたので、上記AlGaAsガイド層と井戸層との $|\Delta E_c|$ を0.12eVよりも確実に大きくして、上記井戸層からの電子のオーバーフローをより確実に抑制することができる。

【0104】

また、1実施例の半導体レーザ装置は、上記xの値を上記下部クラッド層および上部クラッド層のAlの組成比の値よりも小さくしたので、上記AlGaAsガイド層の $|\Delta E_c|$ および $|\Delta E_v|$ を、上記下部クラッド層および上部クラッド層よりも小さくできる。したがって、上記ガイド層中において電子のオーバーフローを抑え込んで、温度特性の向上を図ることができる。

【0105】

また、1実施例の半導体レーザ装置は、上記xの値を、段階的にあるいは連続的に、且つ、上記下部クラッド層および上部クラッド層に近づく程大きくなるように変化させたので、上記AlGaAsガイド層の $|\Delta E_c|$ 、 $|\Delta E_v|$ を、上記井戸層側から下部クラッド層および上部クラッド層側に向かって順次大きくすることができる。したがって、より確実に上記ガイド層中において電子のオーバーフローを抑え込むことができる。

【0106】

また、1実施例の半導体レーザ装置は、上記ガイド層における少なくともバリア層に接している部分の上記xの値を、0.4よりも小さくしたので、上記ガイド層の井戸層に近い

領域のA1組成を低くして、信頼性に悪影響を及ぼすことを防止できる。

【0107】

また、1実施例の半導体レーザ装置は、上記井戸層に圧縮歪を導入したので、低閾値電流化を図ることができる。

【0108】

また、1実施例の半導体レーザ装置は、バリア層に引張歪を導入したので、低閾値電流化を図るために上記井戸層に圧縮歪を導入した場合に、上記引張歪が導入されたバリア層によって、上記井戸層の歪を補償することができる。したがって、結晶内の欠陥を減少させて、より高い信頼性を得ることができるのである。

【0109】

また、第2の発明の光ディスク装置は、従来よりも高い光出力で安定に動作する上記第1の発明の半導体レーザ装置を発光装置として用いたので、光ディスクの回転数を従来よりも高速にしてもデータの読み書きを行うことができる。特にCD-R、CD-RW等への書き込み時に問題となっていた光ディスクへのアクセス時間を、格段に短くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の半導体レーザ装置における構成を示す図である。

【図2】図1に示す半導体レーザ装置および他のバリア層構成を有する半導体レーザ装置における活性領域近傍のエネルギーバンドを示す図である。

【図3】図1におけるGaAs基板、InGaAsP井戸層、InGaPバリア層およびAlGaAsガイド層のエネルギーバンドの関係を示す図である。

【図4】InGaAsPの等E_g線図である。

【図5】InGaAsPの等E_c線図である。

【図6】InGaAsPの等E_v線図である。

【図7】InGaAsPの等格子定数線図である。

【図8】GaAs基板に格子整合するGaAs、InGaAsP、AlGaAsおよびIn_{0.4}Ga_{0.6}PのE_c、E_vの関係を示す図である。

【図9】図1とは異なる半導体レーザ装置における構成を示す図である。

【図10】図9に示す半導体レーザ装置における活性領域近傍のエネルギーバンドを示す図である。

【図11】この発明の光ディスク装置の構成図である。

【図12】井戸層／バリア層にAlが入っていない従来のInGaAsP量子井戸半導体レーザ装置の構造を示す図である。

【図13】図12に示す半導体レーザ装置における活性領域近傍のエネルギーバンドギャップ(E_g)を示す図である。

【符号の説明】

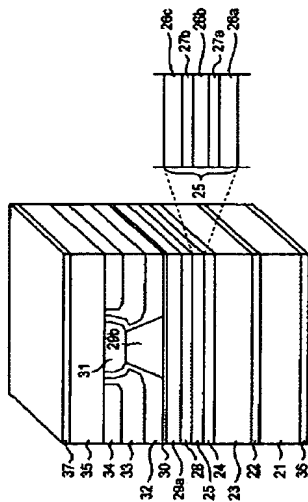
- 21, 41...GaAs基板、
- 22, 42...GaAsバッファ層、
- 23...AlGaAs下部クラッド層、
- 24...AlGaAs下部ガイド層、
- 25, 45...活性領域、
- 26...InGaPバリア層、
- 27, 47...InGaAsP井戸層、
- 28...AlGaAs上部ガイド層、
- 29a, 49a...AlGaAs上部第1クラッド層、
- 29b, 49b...AlGaAs上部第2クラッド層、
- 30, 50...GaAsエッチングストップ層、
- 31, 51...GaAs保護層、
- 32, 52...AlGaAs第1電流ブロック層、
- 33, 53...GaAs第2電流ブロック層、

34, 54...GaAs埋込み保護層、
 35, 55...GaAsキャップ層、
 36, 56...n側電極、
 37, 57...p側電極、
 43a...AlGaAs下部第2クラッド層、
 43b...AlGaAs下部第1クラッド層、
 44a...AlGaAs下部第2ガイド層、
 44b...AlGaAs下部第1ガイド層、
 46...InGaAsPバリア層、
 48a...AlGaAs上部第1ガイド層、
 48b...AlGaAs上部第2ガイド層、
 61...光ディスク、
 62...半導体レーザ装置、
 63...コリメートレンズ、
 64...ビームスプリッタ、
 65...λ/4偏光板、
 66...レーザ光照射用対物レンズ、
 67...再生光用対物レンズ、
 68...信号検出用受光素子、
 69...信号光再生回路。

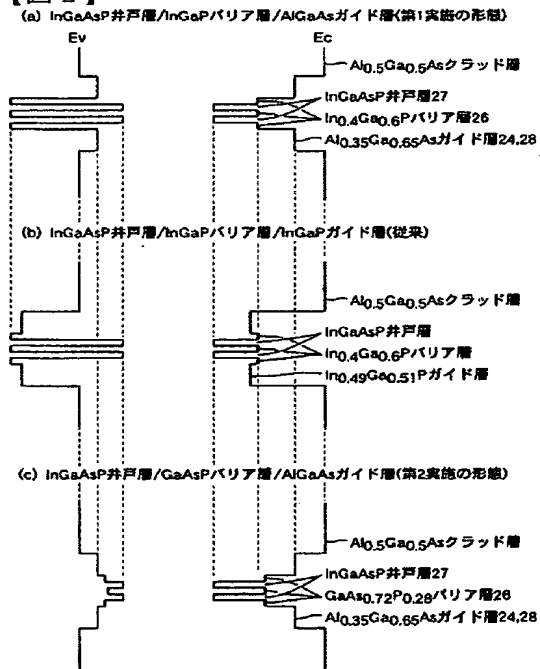
10

20

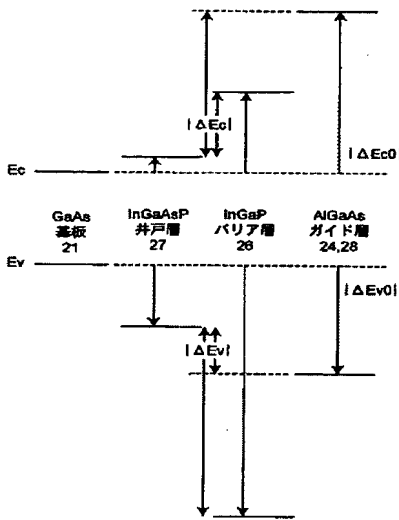
【図1】



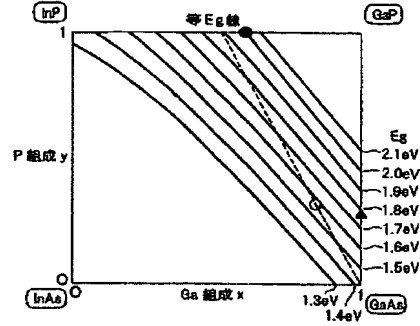
【図2】



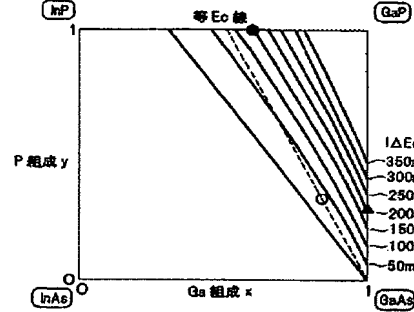
【図 3】



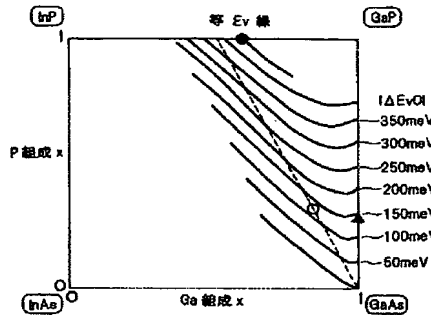
【図 4】



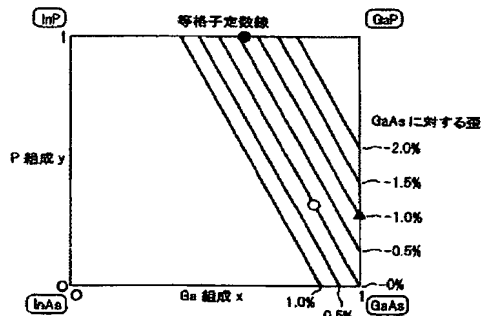
【図 5】



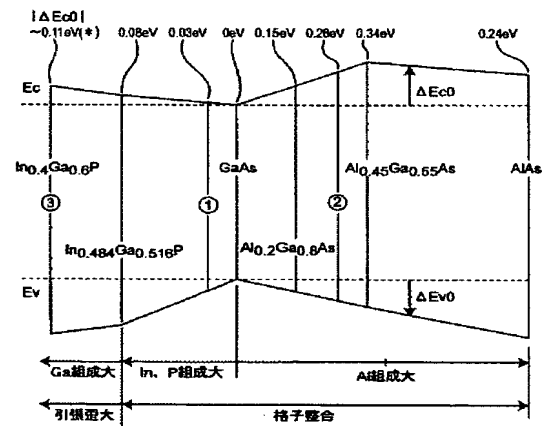
【図 6】



【図 7】

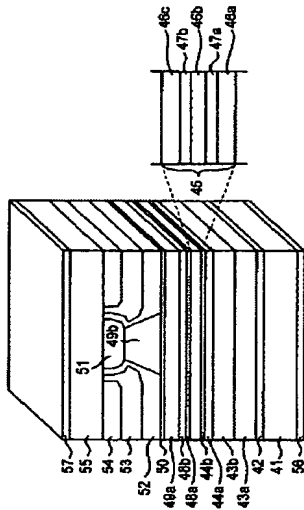


【図 8】

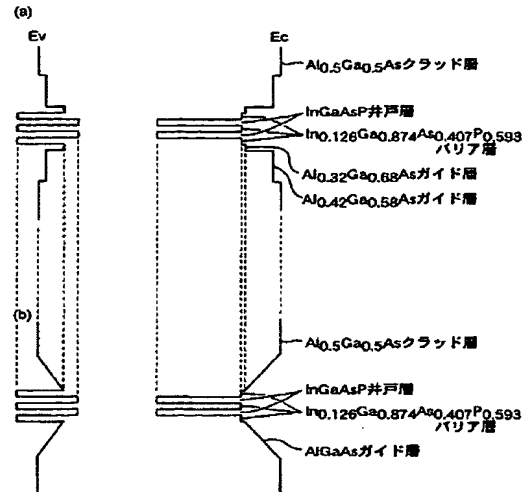


(*) : 歪の影響を考慮した推定値

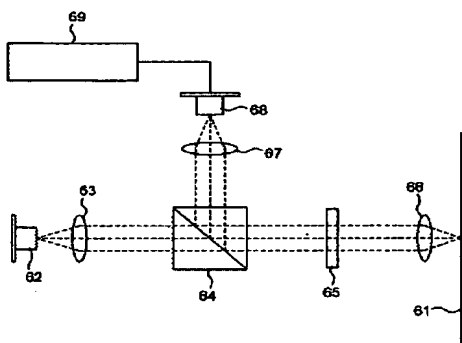
【図 9】



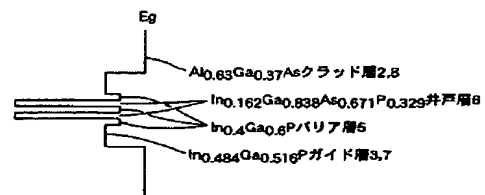
【図 10】



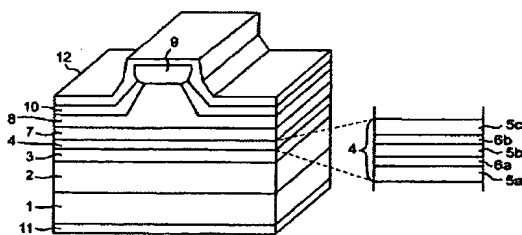
【図 11】



【図 13】



【図 12】



フロントページの続き

F ターム(参考) 5D119 AA24 AA42 BA01 FA05 FA17

5D789 AA24 AA42 BA01 FA05 FA17

5F073 AA13 AA45 AA74 AB27 BA05 CA13 CB02 DA05 EA23

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)